

Examen de Electrónica 2
10/02/2012

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.
La prueba es **sin** material.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1 (37 puntos):

- Determine la ganancia diferencial a bajas frecuencias del amplificador de la Figura.
- Suponga que el valor de C_{μ} en Q3 y Q4 es distinto de cero. Que ventaja aporta la presencia de Q5 y Q6 desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia del amplificador. (Puede considerar el resto de los transistores como ideales en su respuesta en frecuencia).
- Calcule el valor de C_c para obtener un $f_T=250\text{MHz}$ en el amplificador.
- Calcule el S_R del amplificador

Datos:

Transistores: $V_{BE} = |V_{EB}| = 0.7\text{V}$, Tensión de Early: $V_A = 50\text{V}$, $\beta = 200$, excepto Q11 y Q12 con $\beta_{OUT} = 20$

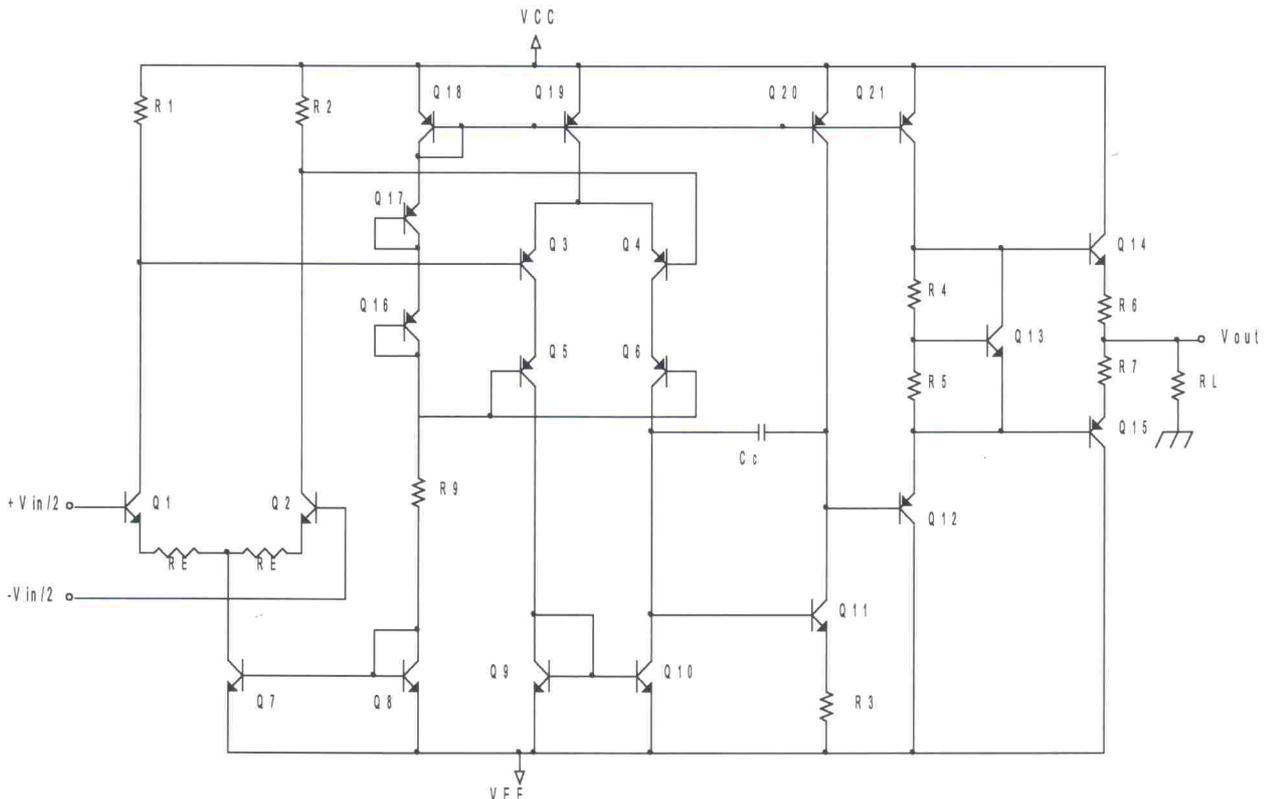
La corriente inversa de saturación de todos los transistores es $I_S = I_{SQ8}$ excepto:

$I_{SQ7} = 10 * I_{SQ8}$, $I_{SQ19} = I_{SQ20} = 3 * I_{SQ8}$, $I_{SQ21} = 10 * I_{SQ8}$, $I_{SQ14} = I_{SQ15} = 2 * I_{SQ8}$

$R1 = R2 = 2\text{k}\Omega$, $R9 = 33\text{k}\Omega$, $R3 = 100\ \Omega$, $R_E = 100$

$R4 = R5 = 2\text{k}\Omega$, $R6 = R7 = 5\ \Omega$, $R_L = 300\ \Omega$.

$V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{V}$



Problema 2 (37 puntos):

a) En el amplificador de la figura la inductancia L_B representa una inductancia parásita debido al cableado que a los efectos de esta parte se considerará es nula. Determinar la ganancia V_o/V_i a frecuencias medias y frecuencia de corte superior del amplificador si en la entrada V_i se tiene una fuente de señal con resistencia de salida 0.

b) Al implementar físicamente este amplificador se observa que con entrada $V_i = 0V$ el mismo oscila a una frecuencia de 80 Mhz y con una amplitud tal que el transistor se puede considerar operando linealmente. Se conjetura que ello se deba al efecto de la inductancia L_B debida al conexionado de V_i . Determinar si esto es posible y en caso afirmativo que valor debiera tener L_B para que esto ocurriera (dar la expresión literal y numérica).

Se sugiere:

considerar que L_B es tal que su impedancia a la frecuencia de oscilación es mucho menor que la impedancia a esta frecuencia de C_{pi} en paralelo con r_{pi} del transistor, verificando luego que este es efectivamente el caso y observar que la impedancia de C_{mu} a la frecuencia de oscilación es mucho mayor que R_L .

Datos:

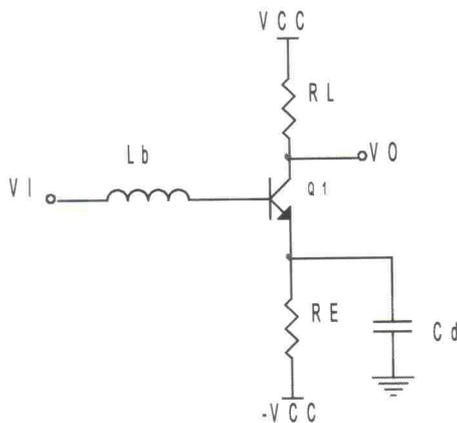
$$R_E = R_L = 270 \text{ Ohms.}$$

C_D : condensador de desacople que se considerará infinito.

$$V_{CC} = 5V$$

Datos transistor:

$$\beta = 300, V_{BE} = 0.7V, f_T (@ I_c = 1mA) = 2 \text{ GHz}, C_{mu} = 0.5pF, C_{je} = 2pF.$$

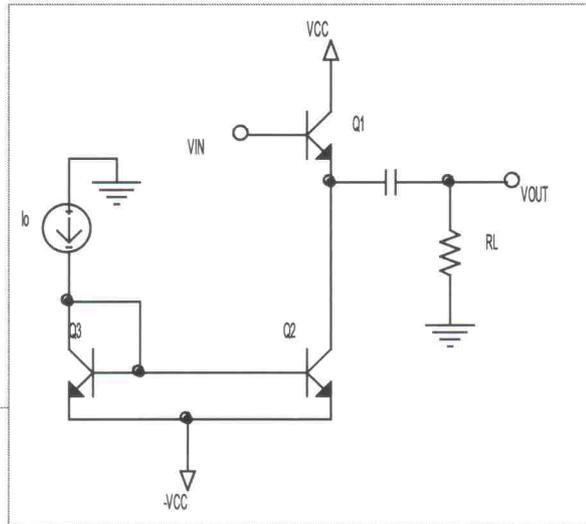
**Pregunta (26 ptos):**

- Para la etapa de potencia de la figura, determinar la máxima eficiencia que sería posible alcanzar para una señal de entrada sinusoidal, indicando bajo que condiciones se alcanzaría esta eficiencia máxima.
- En el caso particular en que $V_{CC} = 5V$, $I_o = 1A$, $R_L = 4\Omega$, $V_{opico} = 2V$, V_{BE} para todos los transistores es $0.8V$ y el nivel de continua en V_{IN} es $0.8V$, determinar, la potencia entregada a la carga, el rendimiento y la potencia disipada por cada uno de los transistores Q_1 , Q_2 y Q_3 .
- Se implementa el circuito con transistores TIP 41, de los que se adjuntan datos y se considerará que la tensión base-emisor es de $0.8V$. Se desea que el circuito

opere con una temperatura ambiente máxima de 45°C y se está en las condiciones de la parte b).

1. Indicar para cada transistor si se requiere utilizar un disipador, explicando claramente porqué si o porqué no y que datos de la hoja de datos utiliza para deducir esto.
2. Para los transistores que se requiera utilizar un disipador, se desea utilizar el mismo para todos. Determinar que condición debe cumplir su resistencia térmica disipador – ambiente si se monta de modo que la resistencia térmica disipador – carcasa del dispositivo (“case”) es 0.5°C/W.

NOTA: Se despreciará en todo el problema la potencia disipada debido a las corrientes de base de los transistores.



Complementary Silicon Plastic Power Transistors

... designed for use in general purpose amplifier and switching applications.

- Collector–Emitter Saturation Voltage —
 $V_{CE(sat)} = 1.5 \text{ Vdc (Max) @ } I_C = 6.0 \text{ Adc}$
- Collector–Emitter Sustaining Voltage —
 $V_{CEO(sus)} = 60 \text{ Vdc (Min) — TIP41A, TIP42A}$
 $= 80 \text{ Vdc (Min) — TIP41B, TIP42B}$
 $= 100 \text{ Vdc (Min) — TIP41C, TIP42C}$
- High Current Gain — Bandwidth Product
 $f_T = 3.0 \text{ MHz (Min) @ } I_C = 500 \text{ mAdc}$
- Compact TO–220 AB Package

*MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	TIP41A TIP42A	TIP41B TIP42B	TIP41C TIP42C	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	100	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CB}	60	80	100	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EB}	5.0			Vdc
Collector Current — Continuous Peak	I_C	6 10			Adc
Base Current	I_B	2.0			Adc
Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	65 0.52			Watts W/°C
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	2.0 0.016			Watts W/°C
Unclamped Inductive Load Energy (1)	E	62.5			mJ
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	– 65 to + 150			°C

THERMAL CHARACTERISTICS

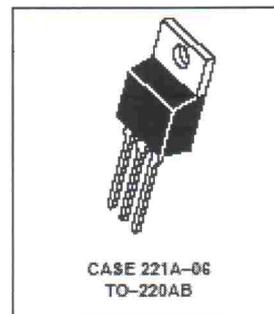
Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.92	°C/W

(1) $I_C = 2.5 \text{ A, L} = 20 \text{ mH, P.R.F.} = 10 \text{ Hz, } V_{CC} = 10 \text{ V, } R_{BE} = 100 \Omega$

NPN
TIP41A
TIP41B*
TIP41C*
PNP
TIP42A
TIP42B*
TIP42C*

*Motorola Preferred Device

6 AMPERE
POWER TRANSISTORS
COMPLEMENTARY
SILICON
60–80–100 VOLTS
65 WATTS



Problema 1



$$I_{R9} = \frac{V_{CC} - V_{EE} - 4V_{BE}}{R_9} = 218,2 \text{ mA}$$

$$I_{SQ7} = 10 I_{SQ8} \Rightarrow I_{Q7} = 2,2 \text{ mA} \parallel I_{Q1} = I_{Q2} = \frac{I_{Q7}}{2} = 1,1 \text{ mA}$$

$$I_{SQ19} = 3 I_{SQ8} \Rightarrow I_{Q19} = 654,6 \text{ mA} \parallel I_{Q3} = I_{Q4} = I_{Q5} = I_{Q6} = \frac{I_{Q19}}{2} = 327 \text{ mA}$$

$$I_{Q19} = I_{Q20} = I_{Q11} = 654,6 \text{ mA}$$

1^{er} etapa

$$S_1 = \frac{\beta(R_{11} \parallel V_{\pi 3})}{V_{\pi 1} + (\beta+1)R_E} = 14,3$$

2^a etapa

$$G_2 = g_{m4} \cdot (R_{O2} \parallel R_{i3}) = 298$$

$$R_{O2} = r_{o10} \parallel R_{O6} \text{ y } R_{i3} = V_{\pi 11} + (\beta+1)R_3 = 28 \text{ k}$$

3^{er} etapa

$$G_3 = \frac{\beta_{out} \beta^2 R_L}{V_{\pi 11} + (\beta+1)R_3} = 28,5 \Rightarrow G = G_1 G_2 G_3 \Rightarrow \boxed{G = 121,5 \times 10^3}$$

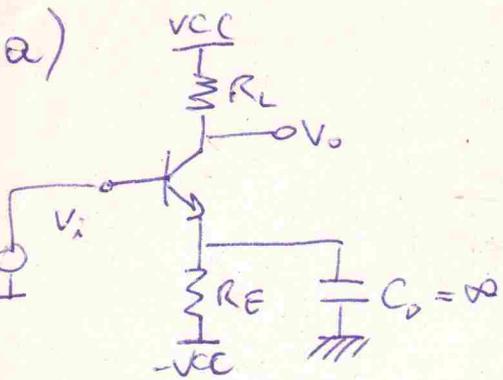
Como es una configuración Cascode el efecto Miller se ve disminuido ya que la ganancia entre base y colector de Q3 y Q4 es -1.

$$G_m = g_{m4} G_1 = 0,18 \Rightarrow C_c = \frac{G_m}{2\pi f_T} = \boxed{114,5 \text{ pF}}$$

$$SR = \frac{I_{Q19}}{C_c} = \boxed{5,7 \times 10^6 \text{ V/\Delta}}$$

SOLUCION PROBLEMA 2

10/2/12
ELECTRO 2



$$G = -R_L \cdot g_m = -\frac{R_L \cdot I_c}{V_T}$$

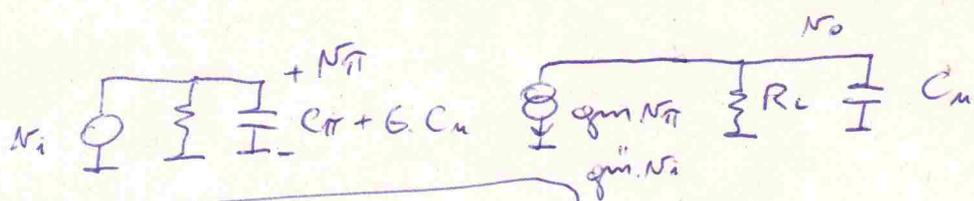
$$I_c = \frac{-V_{BE} + V_{cc}}{R_E} = 16 \text{ mA} \quad V_T = 26 \text{ mV}$$

$$G = -165 \text{ V/V}$$

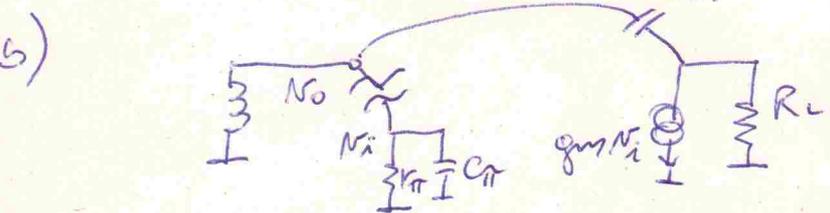
$$g_m = \frac{I_c}{V_T} = 613 \text{ mS}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 489 \text{ K}$$

MODELO PEQUEÑA SEÑAL CON MILLER



$$f_c = \frac{1}{2\pi R_L C_M} = 1,18 \text{ GHz}$$



SE ABRE EL LAZO

$$\frac{N_o}{N_i} = -g_m R_L \frac{L C_M s^2}{L C_M s^2 + 1} \quad (\text{SUPONIENDO } |Ls| \ll \left| r_{\pi} \parallel \frac{1}{C_{\pi} s} \right|)$$

COND. OSCILACIÓN: $N_o/N_i = 1$ $s = j\omega$ $f_{osc} = 80 \text{ MHz}$

ENTONCES: $L = \frac{1}{C_M (2\pi f_{osc})^2 (1 + g_m R)} = 4,8 \times 10^{-8} \text{ H}$ $\omega = 2\pi f_{osc}$

$$L = 48 \text{ nH}$$

VERIFICO: $L \cdot \omega = 24,13 \Omega$

$C_{\pi} @ 1 \text{ mA} = 26 \text{ GHz} = \frac{g_m @ 1 \text{ mA}}{2\pi (C_{\pi} @ 1 \text{ mA} + C_M)}$; $C_{\pi} = C_{je} + K \cdot I_c$; SE LLEGA A QUE $C_{\pi} @ 16 \text{ mA} = 10 \text{ pF}$

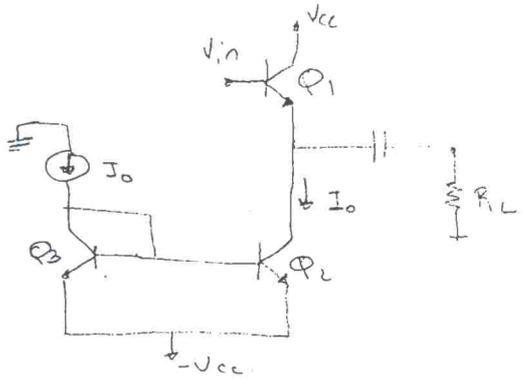
ENTONCES: $\left| r_{\pi} \parallel \frac{1}{C_{\pi} j\omega} \right| = \left| 489 \text{ k}\Omega \parallel \frac{1}{j10 \text{ pF} \times 2\pi \times 80 \text{ MHz}} \right|$
 $\approx 200 \Omega$

SE VERIFICA QUE $|Lj\omega| \ll \left| r_{\pi} \parallel \frac{1}{C_{\pi} j\omega} \right|$

OBSERVAMOS QUE $\left| \frac{1}{C_{\mu} j\omega} \right| \approx 4 \text{ k}\Omega \gg R_L = 270 \Omega$

B

Pregunta



a) $\eta = \frac{P_L}{P_S}$

$P_L = \frac{\hat{V}_o^2}{2R_L}$

$P_{S+} = V_{cc} \cdot I_o$

$P_{S-} = 2V_{cc} I_o$

$\eta = \frac{\hat{V}_o^2}{6 \cdot V_{cc} I_o R_L} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\hat{V}_o}{V_{cc}} \cdot \frac{\hat{V}_o}{R_L I_o}$

La eficiencia máxima se alcanzará cuando $\hat{V}_o = V_{cc}$ y $R_L = \frac{V_{cc}}{I_o} = \frac{\hat{V}_o}{I_o}$

En este caso $\eta = 1/6$

b)

$V_{cc} = 5V$

$I_o = 1A$

$R_L = 4\Omega$

$\hat{V}_o = 2V$

$V_{BE} = 0.8$

$P_L = \frac{\hat{V}_o^2}{2 \cdot R_L} = 0.5W$

$\eta = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4 \cdot 1} = 0.033 \rightarrow 3.3\%$

$P_D = P_{S+} + P_{S-} - P_L = 3 \cdot V_{cc} \cdot I_o - P_L = 14.5W$

$P_{DQ3} = V_{BE} \cdot I_o = 0.8W$

$P_{DQ2} = V_{cc} \cdot I_o = 5W$

$P_D^{trans Q1} = P_{S+} + P_{S-} - P_L = 14.5W$

$P_D^{trans Q1} = P_{DQ1} + P_{DQ2}$

$P_{DQ4} = 4.5W$



c)

$$T_{amb} = 45^{\circ}\text{C}$$

$$a) T_{amb} + R_{\theta JA} \cdot P_D = T_J$$

$$Q_3: 45^{\circ}\text{C} + 62,5^{\circ}\text{C}/\text{W} \cdot 0,8\text{W} = 95^{\circ}\text{C} < T_J^{max} = 150^{\circ}\text{C}$$

↳ No es necesario

$$Q_1, Q_2: 45^{\circ}\text{C} + 62,5^{\circ}\text{C}/\text{W} \cdot 5\text{W} = 358^{\circ}\text{C} > T_J^{max}$$

↳ Es necesario

De la hoja de datos se utilizar los sig. datos: $R_{\theta JA}$, T_J

b)

$$T_{amb} + (R_{\theta JC} + R_{\theta CB} + R_{\theta JA}) \cdot P_D < T_J^{max}$$

- Tomo el transistor p' está más limitado: Q_2

$$R_{\theta DA} < \frac{(T_J^{max} - T_{amb})}{P_D} - R_{\theta JC} - R_{\theta CB} = \underline{18,6^{\circ}\text{C}/\text{W}}$$

R. Trujillo